证券代码:688082　证券简称:盛美上海　公告编号:2026-010

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目"研发和工艺测试平台建设项目"的内部投资结构。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议,保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1338号),公司于2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股(以下简称"本次发行"),每股的发行价为人民币116.11元,募集资金总额为人民币4,481,999,961.86元,扣除各项发行费用人民币46,984,264.81元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号《验资报告》予以确认。

为规范公司及子公司募集资金的管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司及子公司盛帷半导体设备(上海)股份有限公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《盛美半导体设备(上海)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-075)的相关内容,本次发行募集资金扣除各项发行费用后,将用于投入以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	拟投资总额	调整前拟使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金投资金额
1	研发和工艺测试平台建设项目	94,034.85	92,234.85	92,234.85
2	高端半导体设备迭代研发项目	225,547.08	225,547.08	220,848.65
3	补充流动资金	130,418.07	130,418.07	130,418.07
合计		450,000.00	448,200.00	443,501.57

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

(一)调整部分募投项目内部投资结构的原因

公司本次对"研发和工艺测试平台建设项目"(以下简称"募投项目")进行内部投资结构调整,系结合公司最新研发测试需求及资产配置情况做出的合理优化安排,具体原因如下:

1、鉴于募投项目中部分原计划采购的设备已在公司其他项目完成购置,并可完全满足"研发和工艺测试平台建设项目"的运行需求;同时,部分设备的使用需求已不再存在。为避免资产重复配置、提高资金使用效率,公司决定取消前述设备的采购及相应购置预算;

2、在设备性能指标满足募投项目建设要求的前提下,对募投项目中部分拟采购设备的型号进行调整,从而实现该类设备购置成本的合理降低;

3、为适配公司最新的研发与工艺测试要求,满足更高精度、更复杂的技术标准,保障前沿技术方案的顺利实施及工艺测试有效性,公司决定升级部分采购设备的型号和规格,并相应上调该类设备的购置预算;

4、为持续聚焦研发测试投入,全面提升公司研发测试能力,强化公司竞争力,公司结合项目建设的实际需求,拟新增颗粒、液体、管路、气体、电气检测仪器、洁净室配套设备以及部分软件工具等的采购。

综上,为保障募集资金的高效、合理使用,确保项目建设顺利推进,更好地支撑公司相关业务发展,公司拟对"研发和工艺测试平台建设项目"内部投资结构进行优化调整。

(二)调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

公司"研发和工艺测试平台建设项目"内部投资结构调整情况如下:

单位:万元

募投项目名称	项目	原计划投资额	原募集资金拟投入金额	调整后计划投资额	调整后募集资金投入金额	调整金额
研发和工艺测试平台建设项目	硬件设备投资	89,057.00	89,057.00	88,657.00	88,657.00	-400.00
	软件工具投资	500.00	500.00	900.00	900.00	+400.00
	预备费	4,477.85	2,677.85	4,477.85	2,677.85	0.00
合计		94,034.85	92,234.85	94,034.85	92,234.85	0.00

公司本次对"研发和工艺测试平台建设项目"的内部投资结构进行调整,未涉及项目实施主体变更,未改变项目投资总额,仅根据项目实际实施条件及最新资产配置情况,对拟购买软硬件设备进行增减调节。具体情况如下:

单位:万元

序号	调整内容	调整金额
1	因已在其他项目完成购置,而取消购置的设备	-4,114.72
2	因使用需求取消,而取消购置的设备	-2,250.00
3	因调整部分采购设备的型号,而下调的购置预算	-7,820.00
4	因升级部分采购设备的型号和规格,上调的购置预算	+5,392.00
5	新增颗粒、液体、管路、气体、电气检测仪器、洁净室配套等设备的采购	+8,392.72
6	调整项目需求管理软件预算,并新增CIM管理软件的采购	+400.00

四、募集资金投资项目内部结构调整对公司的影响

公司本次对"研发和工艺测试平台建设项目"的内部投资结构进行调整,系结合公司业务发展规划及项目最新研发测试需求做出的审慎决策。本次调整为项目内部资源配置的优化安排,未涉及项目实施主体变更,未改变项目投资总额,不属于募投项目的实质性变更,不会影响项目建设的正常推进,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次调整有利于公司优化整体资源配置与募集资金投入结构,提升募集资金使用效率及募投项目实施效率,助力公司实现长期可持续发展。公司将持续严格规范募集资金的管理与使用,确保资金使用合法、合规、高效,切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、公司履行的审议程序

公司于2026年2月26日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议和第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目"研发和工艺测试平台建设项目"的内部投资结构。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

六、专项意见说明

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:本次募投项目内部投资结构调整事项,系结合公司业务发展规划及项目最新研发测试需求做出的审慎决策,有利于公司优化整体资源配置与募集资金投入结构,提升募集资金使用效率,是合理且必要的。本次调整未改变募投项目实施主体和实施方式,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。

综上,审计委员会同意公司本次调整"研发和工艺测试平台建设项目"内部投资结构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整募集资金投资项目内部结构的事项,已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目内部结构,系结合公司最新研发测试需求及资产配置情况做出的合理优化安排,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部结构的事项无异议。

七、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司调整募集资金投资项目内部结构的核查意见》

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年2月27日

公司代码:688082　公司简称:盛美上海

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在2025年年度报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第三届董事会第三次会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:截至2025年12月31日,公司总股本为480,164,789股,以剔除公司回购股份443,400股后的总股本为基准,拟每10股派发现金红利6.233元(含税),共计派发现金红利299,010,341.76元(含税),本次利润分配现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的21.42%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。公司于2025年6月至8月期间,通过集中竞价交易方式实施股份回购金额50,012,340.46元,现金分红和回购金额合计349,022,682.22元,占2025年合并报表归属于母公司股东净利润25.00%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生增减变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	盛美上海	688082	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗明珠	/
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋	/
电话	021-50276506	/
传真	021-50808860	/
电子信箱	ir@acmrcsh.com	/

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司经过多年持续的研发投入和技术积累,先后开发了前道半导体工艺设备,包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备;后道晶圆级先进封装工艺设备、面板级先进封装设备;以及硅材料衬底制造工艺设备等。

(1)前道半导体工艺设备

①清洗设备

A.SAPS兆声波单片清洗设备

晶圆表面的兆声波能量与晶圆和兆声波发生器之间的距离呈现周期性的变化。在传统的兆声波清洗工艺中,不同工序后应力带来的晶圆翘曲,使得晶圆上不同点到兆声波发生器的距离不同,因此晶圆上不同位置的兆声波能量也不相同,无法实现兆声波能量在晶圆表面的均匀分布。而且由于硬件位置控制的误差,也会造成兆声波能量在晶圆表面分布的不均匀。

公司自主研发的SAPS兆声波技术采用扇形兆声波发生器,通过精确匹配晶圆旋转速度、液膜厚度、兆声波发生器的位置、交变位移及能量等关键工艺参数,通过在工艺中控制兆声波发生器和晶圆之间的半波长范围的相对运动,使晶圆上每一点在工艺时间内接收到的兆声波能量都相同,从而很好的控制了兆声波能量在晶圆表面的均匀分布。

B.TEBO兆声波单片清洗设备

公司自主研发的TEBO清洗设备,可适用于28nm及以下的图形晶圆清洗,通过一系列快速(频率达到每秒一百万次)的压力变化,使得气泡在受控的温度下保持尺寸和形状振荡,将气泡控制在稳定震荡状态,而不会内爆,从而保持晶圆微结构不被破坏,对晶圆表面图形结构进行无损伤清洗。公司TEBO清洗设备,在器件结构从2D转换为3D的技术转移中,可应用于更为精细的具有3D结构的Fin-FET、DRAM和新兴3D NAND等产品,以及未来新型纳米器件和量子器件等,在提高客户产品良率方面发挥越来越重要的作用。

公司通过自主研发并具有全球知识产权保护的SAPS和TEBO兆声波清洗技术,解决了兆声波技术在集成电路单片清洗设备上应用时,兆声波能量如何在晶圆上均匀分布及如何实现图形结构无损伤的全球性难题。为实现产能最大化,公司单片清洗设备可根据客户需求配置多个工艺腔体,最高可单台配置18腔体,有效提升客户的生产效率。

C.高温单片SPM设备

随着技术节点推进,工艺温度要求在150摄氏度以上,甚至超过200摄氏度的SPM工艺步骤逐渐增加。高剂量离子注入后的光刻胶去除、无灰化步骤的纯湿法去胶工艺,以及特殊的金属膜层刻蚀或剥离,都对SPM的温度提出了更高的要求。公司的新型单片高温SPM设备使用独特的多级梯度加热系统来预热硫酸,然后将硫酸与过氧化氢混合以达到超高温。同时,公司的腔体支持配置其他多种化学品,并配备在线化学品混配(CIM)系统,可用于动态设置工艺中的化学品配比及温度。该腔体配置还可支持更多的化学品和灵活的辅助清洗方案,比如公司独有的专利技术SAPS和TEBO兆声波技术。该设备可支持300mm晶圆单片SPM(硫酸和过氧化氢混合酸)工艺,可广泛应用于逻辑、DRAM和3D-NAND等集成电路制造中的湿法清洗和刻蚀工艺,尤其适合处理高剂量离子注入后的光刻胶(PR)去除工艺,以及金属刻蚀和剥离工艺。单片中低温SPM清洗设备在多家客户端实现量产26nm颗粒数量少于10颗,平均颗粒数量少于5颗。高温(硫酸温度大于170摄氏度)SPM设备装入盛美上海的专利申请保护的喷嘴技术,可以有效改善清洗腔的氛围,大幅减少清洗腔的清洗频度,增加运行时间,实现26nm小颗粒数量少于10颗,平均颗粒数量少于5颗;19nm小颗粒数量少于10颗;15nm颗粒数量少于20颗,颗粒控制水平达到全球领先水平。

D.单片槽式组合清洗设备

公司自主研发的具有全球知识产权保护的Tahoe清洗设备在单个湿法清洗设备中集成了两个模块:槽式模块和单片模块。Tahoe清洗设备可被应用于光刻胶去除、刻蚀后清洗、离子注入后清洗和机械抛光后清洗等几十道关键清洗工艺中。Tahoe清洗设备的清洗效果与工艺适用性可与单片中低温SPM清洗设备相媲美。该设备通过减少高达75%的硫酸消耗量,仅硫酸一项每年就可节省高达数十万美元的成本,帮助客户降低生产成本又能更好符合国家节能减排政策。该设备具备强大的清洗能力,在26nm颗粒测试中实现了平均颗粒个位数的标准,可满足高端制造的严格要求。

E.单片背面清洗设备

公司研发的单片背面清洗设备采用伯努利卡盘,应用空气动力学悬浮原理,使用机械手将晶圆送入腔体后,使晶圆背朝上,晶圆正面朝下,在工艺过程中,精准流量控制的高纯氮气通过晶圆与卡具之间的空隙。同时,该设备还可精准控制晶圆边缘回刻宽度,做到zero undercut控制。该设备可用于背面金属污染清洗及背面刻蚀等核心工艺。

F.边缘湿法刻蚀设备

该设备支持多种器件和工艺,包括3D NAND、DRAM和逻辑工艺,使用湿法刻蚀方法去除晶圆边缘的各种电介质、金属和有机材料薄膜,以及颗粒污染物。这种方法最大限度地减少了边缘污染对后续工艺步骤的影响,提高了芯片制造的良率,同时整合背面晶圆清洗的功能,进一步优化了工艺和产品结构。

G.前道刷洗设备

设备采用单片腔体对晶圆正背面依工序清洗,可进行包括晶圆背面刷洗、晶圆边缘刷洗、正背面二流体清洗等清洗工序;设备占地面积小,产能高,稳定性强,多种清洗方式灵活可选。该设备可用于集成电路制造流程中前段至后段各道刷洗工艺。

H.全自动槽式清洗设备

公司开发的全自动槽式清洗设备广泛应用于集成电路领域和先进封装领域的清洗、刻蚀、光刻胶去除等工艺,采用纯水、碱性药液、酸性药液作为清洗剂,与喷淋、热浸、溢流和鼓泡等清洗方式组合,再配以常压IPA干燥技术及低压IPA干燥技术,能够同时清洗50片晶圆。该设备自动化程度高,设备稳定性好,清洗效率高,金属、材料及颗粒的交叉污染低。该设备主要应用于40nm及以上技术节点的几乎所有清洗工艺步骤。

②半导体电镀设备

A.前道铜互连电镀铜设备

公司自主开发针对28nm及以下技术节点的IC前道铜互连镀铜技术Ultra ECP map。公司的多阳极局部电镀技术采用新型的电流控制方法,实现不同阳极之间毫秒级别的快速切换,可在超薄籽晶层上完成无空穴填充,同时通过对不同阳极的电流调整,在无空穴填充后实现更好的片内薄膜沉积均匀性,可满足各种工艺的镀铜需求。

B.三维堆叠电镀设备

应用于填充3d硅通孔TSV和2.5D转接板的三维电镀设备Ultra ECP 3d。基于盛美半导体电镀设备的平台,该设备可为高深宽比(深宽比大于10:1)铜应用提供高性能、无孔洞的镀铜功能。该设备为提高产能而设计了堆叠式腔体,能减少消耗品的使用,降低成本,节省设备使用面积。

C.新型化合物半导体电镀设备

Ultra ECP GIII新型化合物半导体电镀设备已实现量产,在深孔镀金工艺中表现优异,台阶覆盖率在同样工艺参数条件下优于竞争对手水平;同时公司开发了去镀金技术并实现模块销售。

③立式炉管系列设备

公司研发的立式炉管设备主要包括低压化学气相沉积炉、氧化退火炉、合金炉和原子层沉积炉,公司炉管产品已经进入多个中国集成电路晶圆制造厂,已通过验证并大量量产。其中等离子体增强原子层沉积炉管已进入中国集成电路晶圆制造厂,通过初步验证,为后续奠定基础。

④前道涂胶显影Track设备

公司的前道涂胶显影Ultra Lith TM Track设备是一款应用于300 mm前道集成电路制造工艺的设备,可提供均匀的下降气流、高速稳定的机械手以及强大的软件系统,从而满足客户的特定需求。该设备功能多样,能够降低产品缺陷率,提高产能,节约总体拥有成本(COO)。涂胶显影Track设备支持主流光刻机接口,支持包括i-line、KrF和ArF系统在内的各种光刻工艺,可确保满足工艺要求的同时,让晶圆在光刻设备中曝光前后的涂胶和显影步骤得到优化。公司首台高产能KrF工艺前道涂胶显影设备已于2025年9月顺利交付中国头部逻辑晶圆制造厂。

⑤等离子体增强化学气相沉积PECVD设备

公司的等离子体增强化学气相沉积Ultra Pmax TM PECVD设备配置自主知识产权的腔体、气体分配装置和卡盘设计,能够提供更好的薄膜均匀性、更优化的薄膜应力和更少的颗粒特性。

⑥前道无应力铜互连平坦化设备

公司的无应力抛光设备将无应力抛光技术SFP(Stress-Free-Polish)与低下压力化学机械平坦化技术CMP相结合,集成创新了低k/超低k介电质铜互连平坦化Ultra-SFP抛光集成系统,集合二者优点,利用低下压力化学机械抛光先将铜互联结构中铜膜抛至150nm厚度,再采用无应力抛光SFP的智能抛光控制技术将抛光进行到阻挡层,最后采用公司自主开发的热气相刻蚀技术,将阻挡层去除。无应力抛光设备应用于铜低k/超低k互连结构有诸多优点:其一,依靠抛光自动停止原理,平坦化工艺后凹陷更均匀及精确可控;其二,工艺简单,采用环保的可以循环使用的电化学抛光液,没有抛光垫,研磨液等,耗材成本降低50%以上;对互联结构中金属层和介质层无划伤及机械损伤。

⑦新型化合物半导体刻蚀设备

公司推出了6/8英寸化合物半导体湿法工艺产品线,以支持化合物半导体领域的工艺应用,包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。

⑧光刻胶固化设备

该设备专为解决光刻工艺中均匀性不足、温度漂移及临界尺寸变异等难题而设计,助力制造商在器件尺寸持续微缩的趋势下,维持稳定的良率与图形保真度。凭借行业领先的紫外固化均匀性与精密温控技术,该设备可实现高度稳定且可重复的光刻工艺,温度均匀性达±0.1°C。整机采用可配置设计,支持客户根据不同工艺配方与光刻胶集成需求灵活配置。

(2)后道晶圆级先进封装工艺设备

①先进封装电镀设备

公司在半导体先进封装领域进行差异化开发,解决了在更大电镀液流量下实现平稳电镀的难题。采用独创的第二阳极电场控制技术更好地控制晶圆平边或缺口区域的膜厚均匀性控制,实现高电流密度条件下的电镀,凸块产品的各项指标均满足客户要求。在针对高密度封装的电镀领域可以实现2μm超细RDL线的电镀以及包括铜、镍、锡、银和金在内的各种金属层电镀。自主开发的橡胶环密封专利技术可以实现更好的密封效果。

②涂胶设备

公司的升级版8/12英寸兼容的涂胶设备,用于晶圆级封装领域的光刻胶和Polyimide涂布、软烤及边缘去除。涂胶腔内采用了公司特有的全方位无死角自动清洗技术,可缩短设备维护时间。涂胶腔内可兼容两种光刻胶类型。这款升级版涂胶设备对盛美原有的涂胶设备性能和外观都进行了优化升级,可实现热板抽屉式抽出,方便维修及更换,并且能精确复位,有效保障工序运行。

③显影设备

公司的Ultra C dv显影设备可应用于晶圆级封装,是WLP光刻工艺中的步骤。设备可进行曝光后烘烤、显影和坚膜等关键步骤。设备具备灵活的喷嘴扫描系统,精准的药液流量和温度控制系统,更低的成本控制,技术领先,使用便捷。

④湿法刻蚀设备

公司的湿法刻蚀设备使用化学药液进行晶圆球下金属层(UBM)的刻蚀工艺。该设备具备领先的喷嘴扫描系统,可提供行业领先的化学温度控制、刻蚀均匀性。该设备专注安全性,并且拥有药液回收使用功能从而减少成本,刻蚀腔内可兼容至多三种刻蚀药液单独使用及回收,提高使用效率。

⑤湿法去胶设备

公司的Ultra C pr湿法去胶设备设计高效、控制精确,提升了安全性,提高了WLP产能。该设备将湿法槽式浸洗与单片晶圆清洗相结合,单片腔可实现高压去胶及常压去胶,也可单独使用。去胶平台能够在灵活控制清洗的同时,最大限度地提高效率,也可与公司专有的SAPS兆声波清洗设备一同使用,以清除极厚或者极难去除的光刻胶涂层。

⑥金属剥离设备

公司的湿法金属剥离(Metal Lift off)设备基于公司已有的湿法去胶设备平台,将槽式去胶浸泡模块与单片清洗腔体串联起来依序使用,在去胶的同时进行金属剥离。该设备可以在不同单片清洗腔中分别配置去胶功能和清洗功能,并通过优化腔体结构,实现易拆卸、清洗与维护,以解决金属剥离工艺中残留物累积的问题。

⑦后道无应力抛光先进封装平坦化设备

公司拓展开发适用于先进封装3D硅通孔及2.5D转接板中金属铜层平坦化工艺应用,为了解决工艺成本高和晶圆翘曲大的难点,利用无应力抛光的电化学抛光原理,相对比传统化学机械平坦化CMP,没有研磨液、抛光头和抛光垫,仅使用可循环使用的电化学抛光液;并且不受铜层是否经过退火的影响,去除率稳定;通过与CMP工艺整合,先采用无应力抛光将晶圆铜膜减薄至小于0.5μm - 0.2μm厚度,再退火处理,最后CMP工艺的解决方案,能够有效解决CMP工艺存在的技术和成本瓶颈。

⑧带铁环晶圆的湿法清洗设备

公司已经研发出可以应用于带铁环晶圆(tape-frame wafer)的湿法清洗设备,采用公司自主研发的chuck设计和腔体结构,可以支持不同尺寸铁环,可以用于清洗解键合工艺后的胶残留,清洗效果完全满足生产需求,提升工艺制程的良率。

⑨聚合物清洗设备

聚合物清洗设备使用相关有机溶剂清洗干法刻蚀后的聚合物残留,主要应用于2.5D/3D等先进封装工艺。聚合物清洗设备腔体可兼容两种有机溶剂,同时配备二流体清洗功能。聚合物清洗工艺过程中药液需要Dosing功能以保证清洗能力,该设备具有领先的Dosing功能,可根据工艺时间、药液使用时间和有机溶液浓度控制等灵活进行Dosing设定,保证清洗能力。

⑩TSV清洗设备

TSV清洗设备主要应用于2.5D/3D等先进封装工艺中,TSV工艺中孔内会有聚合物残留,可选择使用高温硫酸与双氧水混合液进行清洗。TSV清洗设备具有高效的温度控制能力,可控制Wafer表面清洗时温度在170℃高温。清洗后还可搭配公司专有的SAPS兆声波清洗设备一同使用,保证TSV孔内的清洗效果。

⑪背面清洗/刻蚀设备

背面清洗/刻蚀设备可用于介质层清洗和刻蚀、以及常规硅刻蚀工艺。背洗和背刻设备可通过手臂翻转或者单独的翻转单元进行翻转,腔体使用伯努利原理通过氮气支撑Wafer进行工艺,在完美保护Wafer正面不受影响的情况下进行背面清洗和刻蚀工艺。

⑫键合胶清洗设备

键合胶清洗设备主要用于2.5D/3D工艺中键合胶的去除,涉及到Wafer边缘键合胶去除及正面键合胶去除。设备配备单独的二流体EBR喷嘴,可用于去除Wafer边缘键合胶;正面只用3根二流体喷嘴,可搭配组合使用或单独使用,具有高效的去除效率;同时药液可进行回收以减少成本。

⑬带框晶圆清洗设备

公司的带框晶圆清洗设备可在同一腔体中同时完成清洗和干燥工艺,实现高效清洗和干燥。公司自研的处理技术使该设备能够处理厚度小于150微米的薄晶圆。这款设备可在脱粘后的清洗过程中有效清洗半导体晶圆,其创新溶剂回收系统具有显著的环境与成本效益,该功能可实现近100%的溶剂回收和过滤效果,进而减少生产过程中化学品用量。

⑭化合物电化学去镀设备

公司推出了用于化合物半导体金蚀刻工艺的Ultra ECDP电化学去镀设备,该新设备专为在晶圆图形区域外进行电化学晶圆级金(Au)蚀刻而设计,可实现更高的均匀性、更小的侧蚀和增强的金线外观。

(3)面板级先进封装设备

①面板级先进封装负压清洗设备

面板级先进封装负压清洗设备主要用于更小pitch以及更小的SOH芯片的助焊剂清洗,在2.5D/3D封装应用效果优势明显。专为面板而设计,该面板材料可以是有机材料或者玻璃材料。该设备可处理510×515 mm和600×600 mm的面板以及高达7 mm的面板翘曲。该设备在2025年11月荣获《Global SMT& Packaging》颁发的2025年度全球技术大奖清洁设备类奖项。

②面板级先进封装边缘刻蚀设备

该设备专为面板衬底而设计,可与有机面板、玻璃面板和粘合面板兼容。该设备能有效管理面板的正面和背面,适用尺寸由510mm×515mm至600mm×600mm不等,厚度在0.5mm至2mm之间。该设备可处理最大10mm的翘曲,确保最佳工艺条件。该设备专为铜相关工艺中的边缘刻蚀和清洗而设计,能够同时处理面板的正面和背面的边缘刻蚀,显著提升了工艺效率和产品可靠性。

③水平式面板级先进封装电镀设备

该设备采用公司全球专利申请保护的世界独家水平电镀技术,并支持铜、镍、锡银及金等多材质电镀工艺。该设备可处理510×515mm和600×600 mm的面板。设备配备电镀腔内清洗功能以最大限度减少不同电镀腔之间的化学交叉污染,并采用水平电镀设计,通过同步旋转卡盘与旋转矩形电场实现卓越的膜厚均匀性。该设备在2025年3月获得国际3D InCites协会颁发的"Technology Enablement Award"奖项。

(4)硅材料衬底制造工艺设备

①化学机械研磨后(Post-CMP)清洗设备

公司的CMP后清洗设备用于高质量硅衬底及碳化硅衬底的制造。这款设备在CMP步骤之后,使用稀释的化学药液对晶圆正背面及边缘进行刷洗及化学清洗,以控制晶圆的表面颗粒和金属污染,该设备也可以选配公司独有的兆声波清洗技术。并且这款设备有湿进干出(WIDO)和干进干出(DIDO)两种配置,可以选配2、4或6个腔体,以满足不同产能需求。

②Final Clean清洗设备

公司的Final Clean清洗设备用于高质量硅衬底及碳化硅衬底制造。这款设备在Pre Clean步骤之后,使用稀释的化学药液同时结合公司独有的兆声波清洗技术对晶圆正背面进行化学清洗,以控制晶圆表面颗粒和金属污染。该设备适用于6英寸、8英寸或12英寸晶圆清洗,并且可以选配4腔体、8腔体或12腔体,以满足不同产能需求。

新增重要非主营业务情况

□适用 √不适用

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司作为一家面向国际科技前沿、坚持自主创新的半导体专用设备企业,遵循全球行业惯例,主要从事技术和工艺研发、产品设计和制造,为客户提供设备和工艺解决方案。公司根据对产品的设计,组织零部件外购及外协,建立了完善的供应链体系,与核心供应商建立了密切的合作关系,根据公司的销售预测,提前部署下一年度的产能需求,提前做好产能安排及快速交付计划,保障了对重要零部件的供应。作为设备厂商,公司提供验证平台,通过设备厂商带动零部件技术攻关,实现对零部件企业的商业赋能。公司通过长期研发积累形成的技术优势,保持较高的产品毛利,进而保持较高比例的研发投入及市场开拓,在报告期内实现了较高的利润率。

2、研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司研发部门以半导体专用设备国际技术动态、客户需求为导向,采用差异化竞争的策略,依靠具有丰富经验的国际化研发团队,研发新工艺、新技术,完成技术方案的验证,并在全球主要半导体生产国家及地区申请专利保护,把研发成果快速产业化,取得了一系列的技术创新和突破。此外,公司在韩国组建了专业的研发团队,结合中国上海以及韩国双方研发团队的各自优势,共同研发用于公司产品的差异化技术,提升公司产品性能。公司制定了《研发项目管理办法》,对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了规定。公司将继续吸引优秀人才,扩大充实公司世界一流的研发团队,为全球客户不断地提供最好的工艺解决方案。

3、采购模式

为保障公司产品质量和性能,公司建立了完善的采购体系,在报告期内进一步优化了供应链资源、供应商准入体系和零部件供应策略。持续要求供应商填写《供应商基础信息调查表》,了解供应商的人员构成、财务情况、设计能力、制造能力、检测能力、关键材料/零部件来源、质量管控体系等,对供应商的技术能力、质量能力、交付能力和售后服务等进行综合评估,并最终确定是否纳入合格供应商名录。报告期内,公司保持与主要供应商长期稳定的合作关系。

4、生产模式

公司产品均为根据客户的差异化需求,进行定制化设计及生产制造,主要采取以销定产的生产模式,按客户订单组织生产。

公司根据市场预测或客户的非约束性预测,编制年度生产计划,并结合客户订单情况编制每月生产计划。公司研发设计工程师根据客户订单提供装配图纸,运用MES、WMS系统分发到仓库和生产车间,进行仓库领料、配料和装配,预装配并预检合格后,交由总装配车间进行各模块整体组装生产线组装,然后由测试部门进行各模块的功能测试,测试合格后,下线发货。公司对外协加工的质量严格把关,与外协厂商建立了多年稳定的合作关系,确保符合客户的差异化需求。

5、销售模式

公司自设立以来,始终坚持全球化发展战略,客户主要位于中国大陆、中国台湾、韩国等国家和地区。公司的市场开拓策略为:首先开拓全球半导体龙头企业客户,通过长时间的研发和技术积累,取得其对公司技术和产品的认可,以树立公司的市场声誉。然后凭借在国际行业取得的业绩和声誉,持续开拓中国大陆等半导体行业新兴区域市场。经过多年的努力,公司已与国内外存储及逻辑半导体行业龙头企业形成了较为稳定的合作关系。

公司通过直销模式销售产品,不存在分销和经销模式。报告期内,公司通过委托代理商推广、与潜在客户商务谈判或通过招投标等方式获取订单。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展态势与面临的机遇

①半导体应用和消费市场需求长期保持增长

近年来,受下游消费电子、物联网、工业互联、汽车电子等领域快速发展的影响,中国大陆再次掀起了晶圆产能建设的高潮,带动半导体设备投资大幅上升。SEMI的报告预测,到2026年,各地区12英寸晶圆厂产能,中国大陆晶圆厂产能将达30.6%,对比韩国占比21.6%,中国台湾占比20.2%。这些新建的晶圆产能大多数是中国实体所为。晶圆产能的扩张促进了中国半导体产业专业人才的培养及配套行业的发展,半导体产业环境的良性发展为中国半导体专用设备制造业产业的扩张和升级提供了机遇。

②全球半导体行业区域竞争加剧

半导体行业具有生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高风险大、下游应用广泛等特点,叠加下游新兴应用市场的不断涌现,半导体产业链从集成化到垂直化分工的趋势越来越明确。目前,中国大陆作为全球最大半导体终端产品消费市场,中国半导体产业的规模不断扩大,中国大陆半导体专用设备需求将不断增长。

(2)半导体专用设备行业特点

①半导体专用设备在半导体产业链中的地位至关重要

半导体专用设备作为产业链中发挥着重要的基础性支撑作用,是核心技术与工艺的载体,在产业发展中发挥着重要的基础性支撑作用。半导体专用设备的技术复杂,客户对设备的技术参数、运行的稳定性有苛刻的要求,以保障生产效率、质量和良率。集成电路制造工艺的技术进步,反过来也会推动半导体专用设备企业不断追求技术革新。同时,集成电路行业的技术更新迭代也带来对于设备投资的持续性需求,而半导体专用设备的技术提升,也推动了集成电路行业的持续快速发展。

②半导体专用设备技术壁垒高,通过客户验证难度大

半导体专用设备行业为技术密集型行业,生产技术涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识的综合运用。半导体专用设备价值较高,技术复杂,对下游客户的产品质量和生产效率影响较大。半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求,对新设备供应商的选择也较为慎重。一般选取行业内具有一定市场口碑和市占率的供应商,并对其设备开展周期较长的验证流程。因此,半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长,难度较大。

(3)集成电路设备行业技术门槛

集成电路设备行业技术门槛高,集成电路设备具有技术含量高、制造难度大、设备价值高和行业门槛高等特点,被公认为工业界精密制造最高水平的代表之一。公司的技术水平与国际巨头仍有差距,需加快技术研发与产业化进程。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

全球半导体清洗设备市场高度集中,尤其在单片清洗设备领域,DNS、TEL、LAM与SEMES四家公司合计市场占有率接近90%,其中DNS市场份额最高,市场占有率在41%以上。本土12英寸晶圆厂单片清洗设备主要来自DNS、盛美上海、LAM、TEL。

目前,中国大陆能提供半导体清洗设备的企业较少,主要包括盛美上海、北方华创、芯源微及至纯科技。根据中银证券专题报告的历年累计数据统计显示,公司清洗设备的国内市占率为23%;而Gartner 2025年数据显示,公司清洗设备的国际市占率为8.0%,电镀设备的国际市占率为8.2%,全球排名分别为第四和第三。同时公司亦积极扩大产品组合,在半导体抛铜设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备、前道涂胶显影(Track)设备、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、面板级先进封装设备等领域扩大布局。2024年中国大陆半导体专用设备制造五强企业中,公司位列其中。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

为落实"十五五"发展规划,支撑新一代信息技术产业创新发展,中国正大力推进半导体制造装备与工艺的研发与应用。此举不仅有助于促进科技创新、增强产业链关键环节的竞争力,还能加速制造业转型升级,推动引领性科技攻关,筑牢数字经济发展的基础。

(1)将向高精密化与高集成化方向发展

半导体产业具有"一代设备、一代工艺和一代产品"的特点,半导体产品制造要超前电子系统开发新一代工艺,而半导体设备要超前半导体产品制造开发新一代产品。因此,半导体设备企业需要不断提高技术研发能力,推动产品的迭代升级及新产品研发,持续优化产品布局。随着半导体技术的不断进步,半导体器件集成度不断提高。一方面,芯片工艺节点不断缩小,由12μm-0.35μm(1965年-1995年)到65nm-22nm(2005年-2015年),且还在向更领先的方向发展;另一方面半导体晶圆的尺寸却不断扩大,主流晶圆尺寸已经从4英寸、6英寸,发展到现阶段的8英寸、12英寸。此外,半导体器件的结构也趋于复杂。例如存储器领域的NAND闪存,根据国际半导体技术路线图预测,当工艺尺寸逐渐缩小,目前的Flash存储技术将会达到尺寸缩小的极限,存储器技术将从二维转向三维架构,进入3D时代。在3D NAND制造工艺中,核心思路是将传统2D NAND中在二维平面内横向排布的串联存储单元,转变为垂直方向的堆叠结构。通过增加存储单元的立体层数,有效突破了平面结构在尺寸微缩上的瓶颈。目前,3D NAND的堆叠层数已从早期的32层、64层,逐步发展到200层及以上的技术节点。这些对半导体专用设备的精密度与稳定性的要求越来越高,未来半导体专用设备将向高精密化与高集成化方向发展。

(2)各类技术等级设备并存发展

考虑到半导体芯片的应用极其广泛,不同应用领域对芯片的性能要求及技术参数要求差异较大,如手机使用的SoC逻辑芯片,往往需要使用12英寸晶圆,而对于工业、汽车电子、电力电子用途的芯片,仍在大量使用6英寸和8英寸晶圆及μm级工艺。不同技术等级的芯片需求大量并存,这也决定了不同技术等级的半导体专用设备均存在市场需求。未来随着半导体产业技术的持续发展,适用于12英寸晶圆以及更领先工艺的半导体专用设备需求将以更快的速度成长,但高、中、低各类技术等级的设备均有其对应的市场空间,短期内将持续并存发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	18,894,894,681.46	12,128,452,382.81	55.79	9,753,797,716.90
归属于上市公司股东的净资产	13,469,590,277.25	7,665,635,114.21	75.71	6,458,265,703.22
营业收入	6,786,170,247.76	5,617,740,375.66	20.80	3,888,342,742.05
利润总额	1,456,679,049.20	1,300,669,031.68	11.99	963,814,781.42
归属于上市公司股东的净利润	1,395,929,467.13	1,153,188,090.00	21.05	910,521,979.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,219,908,049.27	1,108,846,723.27	10.02	867,679,683.38
经营活动产生的现金流量净额	238,842,882.82	1,216,142,991.74	-80.36	-426,963,656.49
加权平均净资产收益率(%)	14.82	16.65	减少1.83个百分点	15.19
基本每股收益(元/股)	3.10	2.64	17.42	2.09
稀释每股收益(元/股)	3.07	2.61	17.62	2.05
研发投入占营业收入的比例(%)	18.49	14.93	增加3.56个百分点	16.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,305,866,199.58	1,959,425,642.26	1,881,127,938.23	1,639,750,467.69
归属于上市公司股东的净利润	246,333,965.84	449,438,761.89	570,293,907.88	129,862,831.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	248,037,475.18	426,242,299.75	433,138,896.59	112,489,377.75
经营活动产生的现金流量净额	93,152,164.05	-225,106,109.48	72,985,435.89	297,811,392.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,277						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,296						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
ACM RESEARCH, INC.	0	357,692,308	74.49	0	无	0	境外法人
上海浦东新兴产业投资有限公司	12,918,783	17,534,167	3.65	12,918,783	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,456,165	5,176,224	1.08	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-2,421,730	3,735,764	0.78	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-117,121	3,555,365	0.74	1,113,254	无	0	其他
上海浦东海望私募基金管理有限公司—上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业(有限合伙)	2,583,756	2,583,756	0.54	2,583,756	无	0	其他
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	288,225	2,181,389	0.45	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	-2,730,828	1,851,967	0.39	0	无	0	其他
上海浦东海望私募基金管理有限公司—上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)	1,722,504	1,722,504	0.36	1,722,504	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	47,072	1,602,174	0.33	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东海望私募基金管理有限公司—上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业(有限合伙)和上海浦东海望私募基金管理有限公司—上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)均由上海浦东海望私募基金管理有限公司管理,属于同一基金管理人旗下的不同基金产品。上海浦东新兴产业投资有限公司和上海浦东海望私募基金管理有限公司均受上海浦东科创集团有限公司控制。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

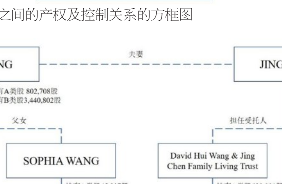
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

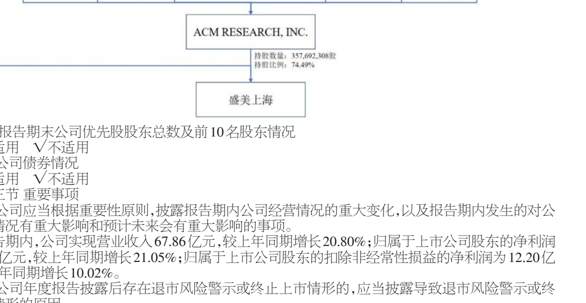
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入67.86亿元,较上年同期增长20.80%;归属于上市公司股东的净利润为13.96亿元,较上年同期增长21.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.20亿元,较上年同期增长10.02%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688082　证券简称:盛美上海　公告编号:2026-012

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票拟归属数量:242.9400万股

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本激励计划方案及履行的程序

1、本激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:首次授予1,064.85万股,占目前公司股本总额的2.22%。

(3)授予价格(调整后):48.50元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股48.50元获得公司A股普通股股票。

(4)激励人数:本激励计划激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员,其中首次授予508人。

(5)具体归属安排如下:

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

(6)任职期限和业绩考核要求

① 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

② 公司层面业绩考核要求

本次激励计划授予的限制性股票考核年度为2023年-2026年四个会计年度,每个会计年度考核一次。根据各考核年度所使用的营业收入增长率累计值(A)、各考核年度的专利申请数(B)进行考核,根据各考核年度业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例,各年度业绩考核目标安排如下表所示:

归属期	对应考核年度	各考核年度所使用的营业收入增长率累计值(A)	业绩考核目标	归属比例(X)
第一个归属期	2023年	2023年营业收入增长率	A≧对标企业算术平均增长率	X=100%
			对标企业算术平均增长率*0.8≦A<对标企业算术平均增长率	X=80%
			A<对标企业算术平均增长率*0.8	0
第二个归属期	2024年	2023年、2024年两年营业收入增长率累计值	A≧对标企业算术平均增长率	X=100%
			对标企业算术平均增长率*0.8≦A<对标企业算术平均增长率	X=80%
			A<对标企业算术平均增长率*0.8	0
第三个归属期	2025年	2024年、2025年两年营业收入增长率累计值	A≧对标企业算术平均增长率	X=100%
			对标企业算术平均增长率*0.8≦A<对标企业算术平均增长率	X=80%
			A<对标企业算术平均增长率*0.8	0
第四个归属期	2026年	2025年、2026年两年营业收入增长率累计值	A≧对标企业算术平均增长率	X=100%
			对标企业算术平均增长率*0.8≦A<对标企业算术平均增长率	X=80%
			A<对标企业算术平均增长率*0.8	0

归属期	对应考核年度	专利申请数(B) 目标值(Bm)	专利申请数(B) 触发值(Bn)	业绩考核目标	归属比例(Y)
第一个归属期	2023年	100	80	B≧Bm	Y=100%
				Bn≦B<Bm	Y=80%
				B<Bn	0
第二个归属期	2024年	120	100	B≧Bm	Y=100%
				Bn≦B<Bm	Y=80%
				B<Bn	0
第三个归属期	2025年	140	120	B≧Bm	Y=100%
				Bn≦B<Bm	Y=80%
				B<Bn	0
第四个归属期	2026年	160	140	B≧Bm	Y=100%
				Bn≦B<Bm	Y=80%
				B<Bn	0

综合上述公司层面业绩考核要求,公司层面归属比例=X*80%+Y*20%。

注:1、"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据;

2、"营业收入增长率"=当年度营业收入相较于上一年度营业收入增长率;

3、对标企业指Gartner公布的相应年度全球半导体设备厂商销售额排名前五位的公司(如Gartner未公布或未及时公布,可采用其他权威机构数据);

4、对标企业算数平均增长率=各对标企业各考核年度的营业收入增长率累计值(计算方法同盛美上海各考核年度所使用的营业收入增长率累计值)之和除以五;

5、当公司营业收入增长率累计值(A)及对标企业算数平均增长率均为负数时,业绩考核目标中的"对标企业算术平均增长率*0.8≦A<对标企业算术平均增长率"应替换为"对标企业算术平均增长率*1.2≦A<对标企业算术平均增长率","A<对标企业算术平均增长率*0.8"应替换为"A<对标企业算术平均增长率*1.2";

6、如对标企业年度报告财务报表日在1-9月内或对标企业考核年度的年度报告在盛美上海董事会审议归属条件是否成就议案的前一日尚未披露,则选取对标企业已披露的最近四个季度财务数据(含考核年度内各季度)之和作为考核年度数据用于比较。如对标企业年度报告财务报表日在10-12月且对标企业考核年度的年度报告在盛美上海董事会审议归属条件是否成就议案的前一日已披露,则将对标企业考核年度的年度报告数据视为考核年度数据;

7、"专利"指公司及下属子公司在全球范围内申请并受理的全部类型的专利。

③ 激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施,并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。

激励对象的等级评定结果划分为优秀(A)、良好(B)、中等(C)、合格(D)、不合格(E)共五个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

等级评定结果	优秀(A)	良好(B)	中等(C)	合格(D)	不合格(E)
归属比例	100%	100%	80%	60%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(2)2023年6月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-024),根据公司其他独立董事的委托,独立董事张苏彤先生作为征集人就公司2022年度股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2023年5月9日至2023年5月18日,公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(4)2023年6月28日,公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划,授权董事会确定限制性股票授予日,并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(5)2023年8月3日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(6)2024年6月25日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(7)2024年10月29日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(8)2025年8月5日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(9)2026年2月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)限制性股票历次授予情况

	授予日期	授予价格(调整后)(元/股)	授予数量(万股)	授予人数(人)	授予后限制性股票剩余数量(万股)
首次授予情况	2023年8月3日	48.50	1,064.85	508	266.15
预留授予情况	2024年6月25日	48.50	139.10	193	127.05

注:1、公司2022年度、2023年度、2024年度权益分派实施方案已实施完毕,因此授予价格由50.15元/股调整为48.50元/股;

2、本激励计划预留限制性股票266.15万股,实际预留授予139.10万股限制性股票。剩余未授予的限制性股票127.05万股作废失效,未来不再授予。

(三)激励对象各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的归属情况如下:

归属期次	归属日期	价格(调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
首次授予部分第一个归属期	2025年3月25日	48.50元/股	255.0435万股	466人	771.4125万股	36名激励对象离职或自愿放弃丧失激励对象资格,23名激励对象因个人绩效考核未达标或部分达标,5名激励对象放弃认购本期可归属股票,前述人员获授的共计38.3940万股限制性股票作废失效。	2022、2023、2024年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由50.15元/股调整为48.50元/股。
预留授予部分第一个归属期第一批次	2025年11月14日	48.50元/股	27.2275万股	174人	89.0625万股	17名激励对象离职或自愿放弃丧失激励对象资格,4名激励对象因个人绩效考核部分达标,前述人员获授的共计22.81万股限制性股票作废失效。	2022、2023、2024年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由50.15元/股调整为48.50元/股。

注:2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期中,有2名激励对象所涉及共计1.5000万股限制性股票暂缓归属,具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2025-080)。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

公司2026年2月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2022年年度股东大会授权,董事会认为:根据本激励计划的规定,本激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为242.9400万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的448名激励对象办理归属相关事宜。董事HUI WANG、王坚、杨霞云为本激励计划的激励对象,已回避对本议案的表决。

(二)关于本激励计划首次授予部分激励对象第二个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,首次授予部分激励对象已进入第二个归属期

根据本激励计划的相关规定,首次授予部分激励对象的第二个归属期为"自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止"。本激励计划首次授予日为2023年8月3日,因此激励对象首次授予的第二个归属期为2025年8月4日至2026年8月3日。

2、符合归属条件的说明

根据公司2022年年度股东大会的授权、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划首次授予部分的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。	公司2023年限制性股票激励计划首次授予的508名激励对象中,36名激励对象在第一个归属期内因个人原因离职或自愿放弃等原因不再具备激励对象资格,23名激励对象在第二个归属期内因个人原因离职不再具备激励对象资格,截至本公告披露日仍在职的449名激励对象符合归属任职期限要求。
(四)满足公司层面业绩考核要求 根据2023、2024年度的营业收入增长率累计值(A)、专利申请数(B)进行考核,根据年度业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例,2023、2024年度业绩考核目标安排如下表所示:	

归属期	对应考核年度	各考核年度所使用的营业收入增长率累计值(A)	业绩考核目标	归属比例(X)
第二个归属期	2024年	2023年、2024年两年营业收入增长率累计值	A≧对标企业算术平均增长率	X=100%
			对标企业算术平均增长率*0.8≦A<对标企业算术平均增长率	X=80%
			A<对标企业算术平均增长率*0.8	0

归属期	对应考核年度	专利申请数(B) 目标值(Bm)	专利申请数(B) 触发值(Bn)	业绩考核目标	归属比例(Y)
第二个归属期	2024年	120	100	B≧Bm	Y=100%
				Bn≦B<Bm	Y=80%
				B<Bn	0

综合上述公司层面业绩考核要求,公司层面归属比例=X*80%+Y*20%。

归属条件	达成情况
(五)满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施,并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。 激励对象的等级评定结果划分为优秀(A)、良好(B)、中等(C)、合格(D)、不合格(E)共五个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量: 等级评定结果:优秀(A) 100%;良好(B) 100%;中等(C) 80%;合格(D) 60%;不合格(E) 0 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。	本期符合归属条件的激励对象共448名,2024年度等级评定结果及个人层面归属比例如下: 1.129名激励对象为"优秀(A)",归属比例为100%; 2.317名激励对象为"良好(B)",归属比例为100%; 3.2名激励对象为"中等(C)",归属比例为80%。 4.1名激励对象为"不合格(E)",归属比例为0%。

综上所述,本激励计划首次授予部分第二个归属期共计448名激励对象达到归属条件,可归属限制性股票数量共计242.9400万股。

(三)对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-011)。

(四)薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《公司法》《证券法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。经核查,本次符合归属条件的激励对象共448名,主体资格合法有效,可归属的限制性股票数量为242.9400万股。公司按照本激励计划的相关规定,为符合条件的激励对象办理归属相关事宜的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,薪酬与考核委员会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记事宜。

三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日:2023年8月3日

(二)归属数量(调整后):242.9400万股

(三)归属人数(调整后):448人

(四)授予价格(调整后):48.50元/股(公司2022年度、2023年度、2024年度权益分派实施方案已实施完毕,因此授予价格由50.15元/股调整为48.50元/股)

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(六)激励对象名单及归属情况

首次授予部分第二个归属期可归属具体情况:

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员(8人)					
HUI WANG	美国	董事长	125.0000	31.2500	25.0000%
王坚	中国	董事、总经理、核心技术人员	93.0000	23.2500	25.0000%
陈福平	中国	副总经理、核心技术人员	72.0000	18.0000	25.0000%
LISA YI LU FENG	美国	财务负责人	31.0000	7.7500	25.0000%
罗明珠	中国	董事会秘书	31.0000	7.7500	25.0000%
李学军	中国	核心技术人员	15.0000	3.7500	25.0000%
王俊	中国	副总经理、核心技术人员	15.0000	3.7500	25.0000%
杨霞云	中国	职工代表董事	8.0000	2.0000	25.0000%
二、董事会认为需要激励的其他人员(440人)					
核心管理(业务)骨干、中层管理(业务)人员、优秀基层技术(业务)员工			582.0000	145.4400	24.9897%
合计			972.0000	242.9400	24.9938%

注:1、上述董事、高级管理人员、核心技术人员任职情况较《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-037)中披露情况存在差异,系公司于2025年11月完成董事会换届选举及高级管理人员聘任所致,据此已对本次归属限制性股票的董事、高级管理人员名单及职务信息作相应更新,前述激励对象原获授限制性股票数量未作调整,详情见公司已披露的相关公告;

2、上表中已剔除因离职丧失激励对象资格的23名激励对象以及因个人层面绩效考核未达标、对应归属比例为0%的1名激励对象所获授的获授限制性股票数量。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为:除23名激励对象因离职丧失激励对象资格,1名激励对象个人层面绩效考核未达标,不符合归属条件外,本次拟归属的448名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的448名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为242.9400万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,参与本激励计划首次授予部分的董事、高级管理人员中,HUI WANG、王坚、陈福平、LISA YI LU FENG及罗明珠在本公告披露日前6个月存在卖出公司股票的行为,系依据公司已披露的减持计划进行的交易,具体内容详见公司于2025年11月22日披露的《实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2025-087)。高级管理人员王俊在本公告披露日前6个月内亦存在卖出公司股票的行为。公司于2025年11月17日召开第三届董事会第一次会议,同意聘任王俊先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核实,相关卖出行为发生在其被聘任为公司副总经理之前,行为发生时其尚不具备公司高级管理人员身份。

除上述情况外,参与本激励计划首次授予部分的其他董事在本公告披露日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所认为:截至本法律意见书出具日,本次归属已经取得现阶段必要的批准和授权;本激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就。

八、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所上海分所关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之法律意见书》。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年2月27日